



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111129003 A

(43)申请公布日 2020.05.08

(21)申请号 201911312110.0

(22)申请日 2019.12.18

(71)申请人 重庆康佳光电技术研究院有限公司

地址 402760 重庆市璧山区璧泉街道鸽山
路69号(1号厂房)

(72)发明人 郑士嵩

(74)专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事
务所(普通合伙) 44268

代理人 王永文

(51)Int.Cl.

H01L 27/02(2006.01)

H01L 27/15(2006.01)

H01L 27/32(2006.01)

H01L 51/52(2006.01)

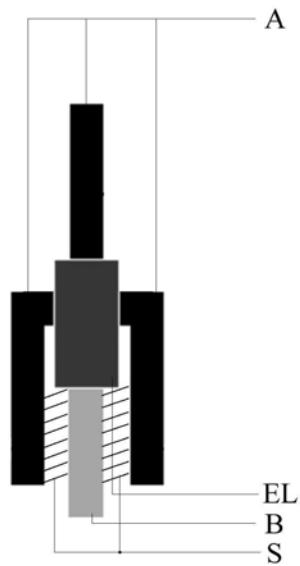
权利要求书2页 说明书6页 附图7页

(54)发明名称

一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置

(57)摘要

本发明提供一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置,所述覆晶结构包括:电致发光器件、与所述电致发光器件的阳极连接的阳极覆晶连线和与所述电致发光器件的阴极连接的阴极覆晶连线,其中,所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间设有绝缘层。本发明中,阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成电容,通过此电容,可以减缓电信号应用到电致发光器件的反应速度,当存在扰动信号时,扰动信号的电压信号变化小,在反应速度降低的条件下,可合理降低非理想扰动的影响,增强显示的稳定性。



1. 一种电致发光器件的覆晶结构,所述覆晶结构设置在基板上,其特征在于,包括:电致发光器件、与所述电致发光器件的阳极连接的阳极覆晶连线和与所述电致发光器件的阴极连接的阴极覆晶连线,其中,所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间设有绝缘层,以使所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成与所述电致发光器件并联的电容。

2. 根据权利要求1所述的覆晶结构,其特征在于,所述阳极覆晶连线包括第一连线、第二连线和第三连线;所述第二连线与所述阴极覆晶连线之间设有所述绝缘层;所述第三连线与所述阴极覆晶连线之间设有所述绝缘层。

3. 根据权利要求2所述的覆晶结构,其特征在于,所述第二连线为弯折状,以所述电致发光器件的阳极为第一原点,所述第二连线包括与第一原点连接的第一子连线,以及与所述第一子连线连接,且与所述第一子连线成直角的第二子连线;所述第三连线为弯折状,所述第三连线包括与第一原点连接的第三子连线,以及与所述第三子连线连接,且与所述第三子连线成直角的第四子连线;所述第一子连线与第三子连线成180度,所述第二子连线与所述第四子连线平行;所述第一连线与所述第一子连线和所述第三子连线均成直角。

4. 根据权利要求3所述的覆晶结构,其特征在于,所述阴极覆晶连线与所述第二子连线以及所述第四子连线均平行。

5. 根据权利要求1所述的覆晶结构,其特征在于,所述阳极覆晶连线包括第四连线,以及与所述第四连线连接,且与所述第四连线成直角的第五连线,所述阴极覆晶连线包括第六连线,以及与所述第六连线连接,且与所述第六连线成直角的第七连线;所述第四连线与所述第六连线之间设有所述绝缘层,所述第五连线与所述第七连线之间设有所述绝缘层。

6. 根据权利要求5所述的覆晶结构,其特征在于,所述第五连线为弯折状,以所述电致发光器件的阳极为第一原点,所述第五连线包括与所述第一原点连接的第五子连线,以及与所述第五子连线连接,且与所述第五子连线成直角的第六子连线;所述第五子连线与所述第四连线垂直,所述第六子连线与所述第四连线平行。

7. 根据权利要求5所述的覆晶结构,其特征在于,所述第六连线为弯折状,以所述电致发光器件的阴极为第二原点,所述第六连线包括与所述第二原点连接的第七子连线,以及与所述第七子连线连接,且与所述第七子连线成直角的第八子连线;所述第七子连线与所述第七连线垂直,所述第八子连线与所述第七连线平行。

8. 根据权利要求1所述的覆晶结构,其特征在于,所述阳极覆晶连线包括第八连线、第九连线和第十连线;所述阴极覆晶连线包括第十一连线,第十二连线和第十三连线;所述第九连线和所述第十二连线之间设有所述绝缘层,所述第十连线和所述第十三连线之间设有所述绝缘层。

9. 根据权利要求8所述的覆晶结构,其特征在于,所述第九连线与所述第八连线连接,且与所述第八连线成直角;所述第十连线与所述第八连线和第九连线连接,且与所述第八连线成直角;所述第十二连线与所述第十一连线连接,且与所述第十一连线成直角;所述第十三连线与所述第十一连线和所述第十二连线连接,且与所述第十一连线成直角。

10. 一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括基板和多个设置在基板上,如权利要求1至9中任一项所述的电致发光器件的覆晶结构,各个所述电致发光器件阵列排布在所述基板上,在阵列的每一横行的电致发光器件接入相同的扫描线,在阵列的每一纵列的电致发光器件接入相同的信号线;各个所述电致发光器件的阳极接入扫描线,各个所述电致

发光器件的阴极接入扫描线。

一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置。

背景技术

[0002] 电致发光(Electroluminescence,EL)器件,包括LED,OLED等,近年来,EL器件大量用于制作显示器产品,相较于传统显示器器件,例如,CRT、LCD等,EL器件在应用方面展现了更好的光学特性、更低的功耗表现和更好的产品形态可塑性。近年来,EL器件发光采用的共电极架构提供了最基底的显示器驱动环境的重要元素之一,根据此架构,可延伸开发出节电应用。

[0003] 目前典型的像素点架构,是通过EL器件的阳极(Anode)与阴极(Cathode)直接与电信号做连接,如图1所示,当两端跨压超过EL器件的正向电压则发光,但是电信号上通常会存在非理想扰动,此非理想扰动若被EL器件吸收,将产生不稳定的亮度抖动,从而影响显示的稳定性,如图2所示,图2是EL器件的电性曲线,当噪声超过EL器件的正向电压(v_F),则会使得EL器件的电流抖动,进而EL器件产生亮度闪烁。但是目前没有针对此问题的有效解决方案。

[0004] 因此,现有技术还有待改进和提高。

发明内容

[0005] 鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置,以实现合理降低非理想扰动的影响,增强显示的稳定性。

[0006] 第一方面,本发明实施例提供了一种电致发光器件的覆晶结构装置,所述覆晶结构设置在基板上,包括:电致发光器件、与所述电致发光器件的阳极连接的阳极覆晶连线和与所述电致发光器件的阴极连接的阴极覆晶连线,其中,所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间设有绝缘层,以使所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成与所述电致发光器件并联的电容。

[0007] 作为进一步的改进技术方案,所述阳极覆晶连线包括第一连线、第二连线和第三连线;所述第二连线与所述阴极覆晶连线之间设有所述绝缘层;所述第三连线与所述阴极覆晶连线之间设有所述绝缘层。

[0008] 作为进一步的改进技术方案,所述第二连线为弯折状,以所述电致发光器件的阳极为第一原点,所述第二连线包括与第一原点连接的第一子连线,以及与所述第一子连线连接,且与所述第一子连线成直角的第二子连线;所述第三连线为弯折状,所述第三连线包括与第一原点连接的第三子连线,以及与所述第三子连线连接,且与所述第三子连线成直角的第四子连线;所述第一子连线与第三子连线成180度,所述第二子连线与所述第四子连线平行;所述第一连线与所述第一子连线和所述第三子连线均成直角。

[0009] 作为进一步的改进技术方案,所述阴极覆晶连线与所述第二子连线以及所述第四子连线均平行。

[0010] 作为进一步的改进技术方案,所述阳极覆晶连线包括第四连线,以及与所述第四连线连接,且与所述第四连线成直角的第五连线,所述阴极覆晶连线包括第六连线,以及与所述第六连线连接,且与所述第六连线成直角的第七连线;所述第四连线与所述第六连线之间设有所述绝缘层,所述第五连线与所述第七连线之间设有所述绝缘层。

[0011] 作为进一步的改进技术方案,所述第五连线为弯折状,以所述电致发光器件的阳极为第一原点,所述第五连线包括与所述第一原点连接的第五子连线,以及与所述第五子连线连接,且与所述第五子连线成直角的第六子连线;所述第五子连线与所述第四连线垂直,所述第六子连线与所述第四连线平行。

[0012] 作为进一步的改进技术方案,所述第六连线为弯折状,以所述电致发光器件的阴极为第二原点,所述第六连线包括与所述第二原点连接的第七子连线,以及与所述第七子连线连接,且与所述第七子连线成直角的第八子连线;所述第七子连线与所述第七连线垂直,所述第八子连线与所述第七连线平行。

[0013] 作为进一步的改进技术方案,所述阳极覆晶连线包括第八连线、第九连线和第十连线;所述阴极覆晶连线包括第十一连线,第十二连线和第十三连线;所述第九连线和所述第十二连线之间设有所述绝缘层,所述第十连线和所述第十三连线之间设有所述绝缘层。

[0014] 作为进一步的改进技术方案,所述第九连线与所述第八连线连接,且与所述第八连线成直角;所述第十连线与所述第八连线和第九连线连接,且与所述第八连线成直角;所述第十二连线与所述第十一连线连接,且与所述第十一连线成直角;所述第十三连线与所述第十一连线和所述第十二连线连接,且与所述第十一连线成直角。

[0015] 第二方面,本发明实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括基板和多个设置在基板上的所述电致发光器件的覆晶结构,各个所述电致发光器件阵列排布在所述基板上,在阵列的每一横行的电致发光器件接入相同的扫描线,在阵列的每一纵列的电致发光器件接入相同的信号线;各个所述电致发光器件的阳极接入扫描线,各个所述电致发光器件的阴极接入扫描线包括所述指示灯和背光灯的亮度调节电路。

[0016] 与现有技术相比,本发明实施例具有以下优点:

[0017] 本发明实施例中,所述覆晶结构包括:电致发光器件、与所述电致发光器件的阳极连接的阳极覆晶连线和与所述电致发光器件的阴极连接的阴极覆晶连线,其中,所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间设有绝缘层。本发明中,阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成电容,通过此电容,可以减缓电信号应用到EL器件的反应速度,当存在扰动信号时,扰动信号的电压信号变化小,在反应速度降低的条件下,可合理降低非理想扰动的影响,增强显示的稳定性。

附图说明

[0018] 图1为现有技术中像素点典型架构的示意图;

[0019] 图2为与图1对应的电性曲线;

[0020] 图3为本发明实施例提供的电致发光器件的覆晶结构的第一示意图;

[0021] 图4为现有技术中电致发光器件的覆晶结构及等效电路的示意图;

[0022] 图5为本发明实施例提供的电致发光器件的覆晶结构及等效电路的示意图;

[0023] 图6为图3对应的电性曲线;

- [0024] 图7为本发明实施例提供的电致发光器件的覆晶结构的第二示意图；
- [0025] 图8为本发明实施例提供的电致发光器件的覆晶结构的第二种实现方式的示意图；
- [0026] 图9为本发明实施例提供的电致发光器件的覆晶结构的第三种实现方式的示意图；
- [0027] 图10为本发明实施例提供的显示装置中的电致发光器件的覆晶结构以阵列排布的示意图；
- [0028] 图11为本发明实施例提供的多个像素阵列组合的示意图。

具体实施方式

[0029] 本发明提供一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置，所述覆晶结构中的阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成电容，通过此电容，可以减缓电信号应用到EL器件的反应速度，当存在扰动信号时，扰动信号的电压信号变化小，在反应速度降低的条件下，可合理降低非理想扰动的影响，增强显示的稳定性。

[0030] 为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0031] 请参阅图3，本发明提供了一种电致发光器件的覆晶结构，所述覆晶结构设置在基板上，基板可以是PCB基板或者Glass基板，所述覆晶结构包括：电致发光器件EL、与所述电致发光器件EL的阳极连接的阳极覆晶连线A和与所述电致发光器件EL的阴极连接的阴极覆晶连线B，其中，所述阳极覆晶连线A和阴极覆晶连线B之间设有绝缘层S(图3中阴影部分)，以使所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成与所述电致发光器件并联的电容。

[0032] 本发明实施例中，所述电致发光器件即EL器件，EL器件的阳极连接阳极覆晶连线，EL器件的阴极连接阴极覆晶连线；在现有技术中，参阅图4，图4中的(1)是现有技术中EL器件的覆晶结构，图4中的(1)中A为阳极覆晶连线，C为阴极覆晶连线，EL为电致发光器件；图4中的(2)是图4中的(1)对应的等效电路图，可见，阳极覆晶连线和阴极覆晶连线成180度，即阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间没有绝缘层，而在本发明中，参阅图5，图5的(1)中，阳极覆晶连线的部分和阴极覆晶连线的部分平行，以使得阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间有绝缘层S(图5中阴影部分)，阳极覆晶连线部分与阴极覆晶连线部分平行，由于阳极覆晶连线与阴极覆晶连线存在电势差(阳极覆晶连线连接在EL器件的阳极，阴极覆晶连线连接在EL器件的阴极)，又阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间设有绝缘层S，因此，可以形成电容C，如图5的(2)所示，图5中的(2)是图5中的(1)对应的等效电路图，此覆晶结构呈现电容与EL器件并联架构，通过此电容，可以减缓电信号应用到EL器件的反应速度，当存在扰动信号时，扰动信号的电压信号变化小，在反应速度降低的条件下，可合理降低非理想扰动的影响，增强显示的稳定性。

[0033] 参见图6，图6是图3中EL器件和电容并联结构对应的电性曲线，由于电容，使得原始噪声(n1)消减，变化为消减后噪声(n2)，进而，减小了EL器件的亮度闪烁，即合理降低了非理想扰动的影响，增强了显示的稳定性。

[0034] 本发明实施例中，阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成电容的形式有多种，在

一种实现方式中,参见图7,所述阳极覆晶连线A包括第一连线1、第二连线2和第三连线3;所述第二连线2与所述阴极覆晶连线B之间设有所述绝缘层S1(图7中阴影部分);所述第三连线3与所述阴极覆晶连线B之间设有所述绝缘层S2(图7中阴影部分)。

[0035] 本发明实施例中,阳极覆晶连线A包括第一连线1、第二连线2和第三连线3,第一连线1的延伸方向与第二连线2的延伸方向不同,第一连线1的延伸方向与第三连线3的延伸方向也不同;以所述第一连线为轴线,所述第二连线2和第三连线3沿轴线对称,第二连线2和第三连线3之间有阴极覆晶连线B。

[0036] 进一步的,继续参阅图7,所述第二连线2为弯折状,以所述电致发光器件的阳极为第一原点,所述第二连线2包括与第一原点连接的第一子连线21,以及与所述第一子连线连接,且与所述第一子连线成直角的第二子连线22;所述第三连线3为弯折状,所述第三连线3包括与第一原点连接的第三子连线31,以及与所述第三子连线连接,且与所述第三子连线成直角的第四子连线32;所述第一子连线21与第三子连线31成180度,所述第二子连线22与所述第四子连线32平行;所述第一连线1与所述第一子连线21和所述第三子连线31均成直角。可见,在本发明实施例中,阴极覆晶连线B与第二子连线22以及第四子连线32均平行。由第二子连线22和阴极覆晶连线B、第四子连线32和阴极覆晶连线B之间形成电容。

[0037] 本发明实施例中,以EL器件的阳极为第一原点0₁,从0₁出发,向Y轴正方向延展第一预设长度,得到第一连线1;从0₁出发,向X轴负方向延展第二预设长度,得到第一子连线21,再转向Y轴负方向延展第一预设长度,得到第二子连线22;从0₁出发,向X轴正方向延展第二预设长度,得到第三子连线31,再转向Y轴负方向,得到第四子连线32。以EL器件的阴极为第二原点0₂,从0₂出发向Y轴负方向延展第一预设长度,得到阴极覆晶连线。所述第一预设长度不超过现有技术中阳极覆晶连线的长度,所述第二预设长度小于两个EL器件之间的间隔距离的一半。

[0038] 本发明提供了另一种实现方式,参阅图8,阳极覆晶连线和阴极覆晶连线分别沿着互相的方向延展,所述阳极覆晶连线包括第四连线4,以及与所述第四连线4连接,且与所述第四连线成直角的第五连线5,所述阴极覆晶连线包括第六连线6,以及与所述第六连线连接,且与所述第六连线成直角的第七连线7;所述第四连线与所述第六连线之间设有所述绝缘层S3(图8中阴影部分),所述第五连线与所述第七连线之间设有所述绝缘层S4(图8中阴影部分)。

[0039] 进一步的,所述第五连线5为弯折状,以所述电致发光器件EL的阳极为第一原点0₁,所述第五连线5包括与所述第一原点0₁连接的第五子连线51,以及与所述第五子连线51连接,且与所述第五子连线成直角的第六子连线52;所述第五子连线51与所述第四连线4垂直,所述第六子连线52与所述第四连线4平行。

[0040] 本发明实施例中,以EL器件的阳极为第一原点0₁,从0₁出发,向Y轴正方向延展第一预设长度,得到第四连线4,从0₁出发,向X轴负方向延展第二预设长度,得到第五子连线51,再转向Y轴负方向延展第一预设长度,得到第六子连线52。

[0041] 本发明实施例中,所述第六连线6为弯折状,以所述电致发光器件EL的阴极为第二原点0₂,所述第六连线6包括与所述第二原点连接的第七子连线61,以及与所述第七子连线连接,且与所述第七子连线成直角的第八子连线62;所述第七子连线61与所述第七连线7垂直,所述第八子连线62与所述第七连线7平行。可知,由第六子连线52与第七连线7之间,以

及第八子连线62与第四连线之间,共同形成电容。

[0042] 本发明实施例中,以EL器件的阴极为第二原点O₂,从O₂出发,向Y轴负方向延展第一预设长度,得到第七连线7;从O₂出发,向X轴的正方向延展第二预设长度,得到第七子连线61,再向Y轴正方向延展得到第八子连线62。

[0043] 本发明提供了另一种实现方式,参见图9,所述阳极覆晶连线包括第八连线81、第九连线82和第十连线83;所述阴极覆晶连线包括第十一连线91,第十二连线92和第十三连线93;所述第九连线82和所述第十二连线92之间设有所述绝缘层S5(图9中阴影部分),所述第十连线83和所述第十三连线93之间设有所述绝缘层S6(图9中阴影部分)。

[0044] 进一步的,所述第九连线82与所述第八连线81连接,且与所述第八连线82成直角;所述第十连线83与所述第八连线81和第九连线82连接,且与所述第八连线81成直角;所述第十二连线92与所述第十一连线91连接,且与所述第十一连线91成直角;所述第十三连线93与所述第十一连线91和所述第十二连线92连接,且与所述第十一连线91成直角。所述第九连线82与所述第十连线83成180度;所述第十二连线92与所述第十三连线93成180度。可知,由第九连线82和第十二连线92之间,以及第十连线83和第十三连线93之间,共同形成电容。

[0045] 本发明实施例中,以EL器件的阳极为第一原点O₁,从O₁出发,向Y轴正方向延展第一预设长度,得到第八连线81;从O₁出发,向X轴负方向延展第一预设长度,得到第九连线82;从O₁出发,向X轴正方向延展第一预设长度,得到第十连线83;以EL器件的阴极为第二原点O₂,从O₂出发,向Y轴负方向延展第一预设长度,得到第十一连线91;从O₂出发,向X轴负方向延展第一预设长度,得到第十二连线92;从O₂出发,向X轴正方向延展第一预设长度,得到第十三连线93。

[0046] 本发明还相应提供一种显示装置,所述显示装置包括基板和多个设置在基板上如上所述的电致发光器件的覆晶结构,各个所述电致发光器件阵列排布在所述基板上,在阵列的每一横行的电致发光器件接入相同的扫描线,在阵列的每一纵列的电致发光器件接入相同的信号线;各个所述电致发光器件的阳极接入扫描线,各个所述电致发光器件的阴极接入扫描线。

[0047] 本发明实施例中,将各个EL器件以阵列排布在基板上,以阵列排布是典型的像素阵列排布,呈现行方向做共阴极,列方向做共阳极,行和列方向在阵列排布下可相互调换;各EL器件以阵列形式排布,具有高稳定性,由于电致发光器件的覆晶结构加入了电容,可以抑制非理想扰动的影响,提高了显示的稳定性。像素阵列为共阳极和共阴极整合方法,使得显示装置具有节电优势。

[0048] 本发明实施例中,每个像素点的结构为一个EL器件和一个电容并联,像素矩阵的构建,参阅图10,像素矩阵的行方向,由多个像素点的阴极做共信号控制,同一行的各像素点的阳极各为独立信号控制列方向,将上述结构多行展开得到像素矩阵。

[0049] 在本发明实施例中,像素阵列的每一横行的EL器件的阴极接入同一扫描线(SCAN),每一纵列的EL器件的阳极接入同一信号线(DATA)。

[0050] 可选地,如图11所示,可以将一个像素阵列的扫描线和信号线连接至驱动芯片DDIC,DDIC连接主控信号HOST,所述像素阵列中的像素点根据HOST传输的信号亮或灭。例如,如图11所示中的每个所述像素阵列的大小为m×n。

[0051] 可选地,利用多个驱动芯片,可以实现多个像素阵列的组合,以完成更大的像素阵列,图11中是z个像素阵列的组合。

[0052] 可选地,m的数量可以通过显示装置的像素大小决定。

[0053] 可选地,n的数量可以通过显示装置的像素大小决定。

[0054] 可选地,z为大于或等于1的整数。例如,z可以是2,也可以是3。在此,不作具体限定。

[0055] 综上所述,本发明提供一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置,所述覆晶结构包括:电致发光器件、与所述电致发光器件的阳极连接的阳极覆晶连线和与所述电致发光器件的阴极连接的阴极覆晶连线,其中,所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间设有绝缘层。本发明中,阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成电容,通过此电容,可以减缓电信号应用到EL器件的反应速度,当存在扰动信号时,扰动信号的电压信号变化小,在反应速度降低的条件下,可合理降低非理想扰动的影响,增强显示的稳定性。

[0056] 可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

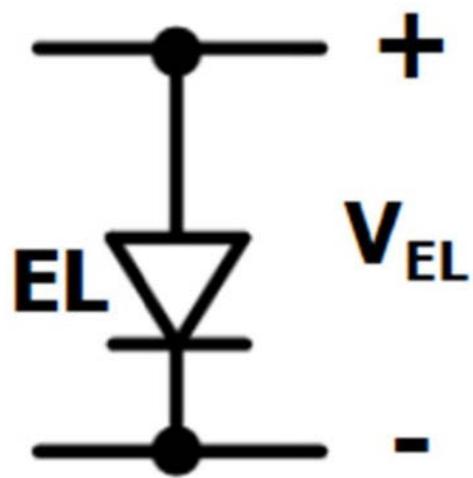


图1

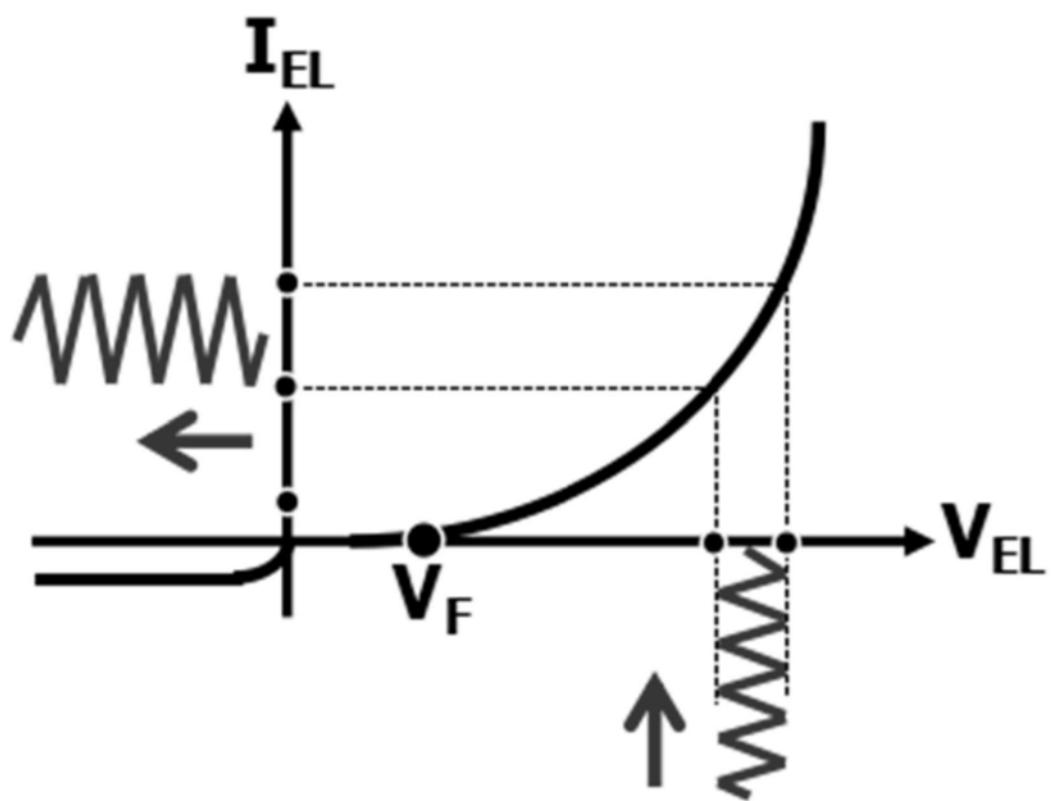


图2

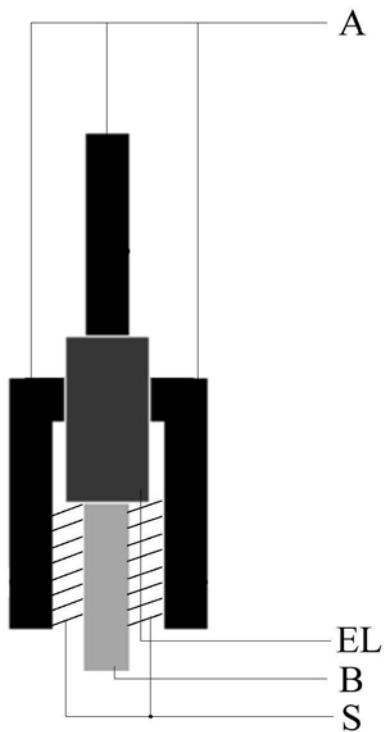


图3

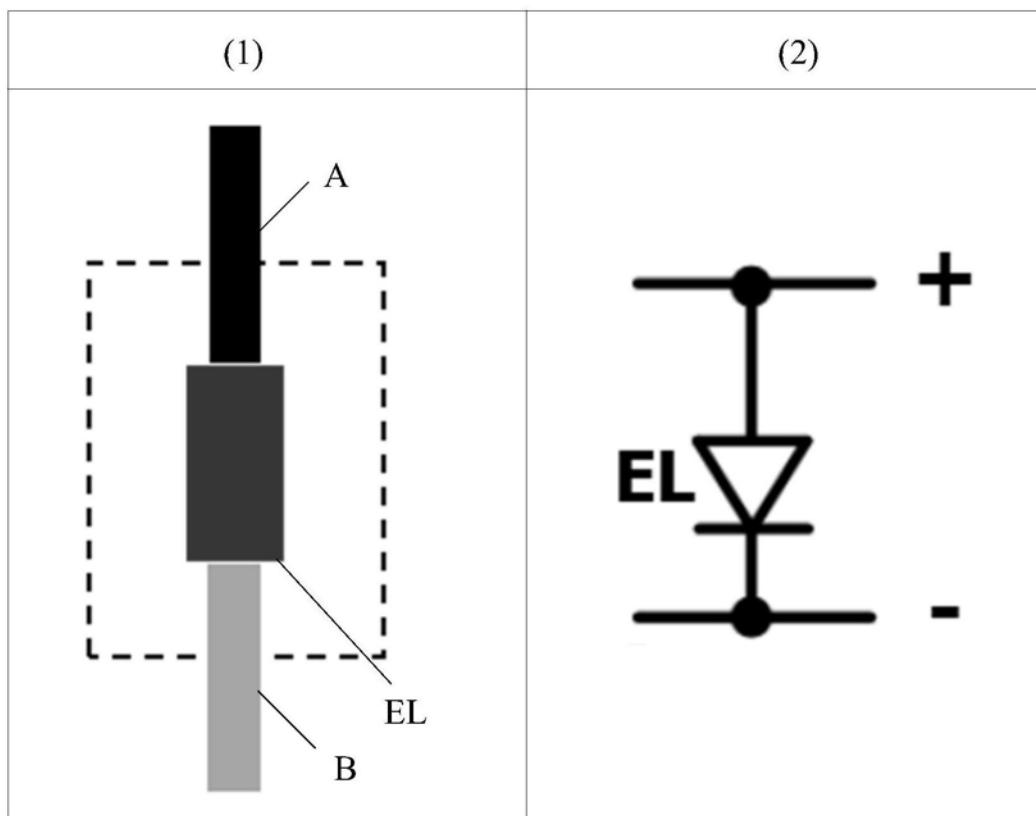


图4

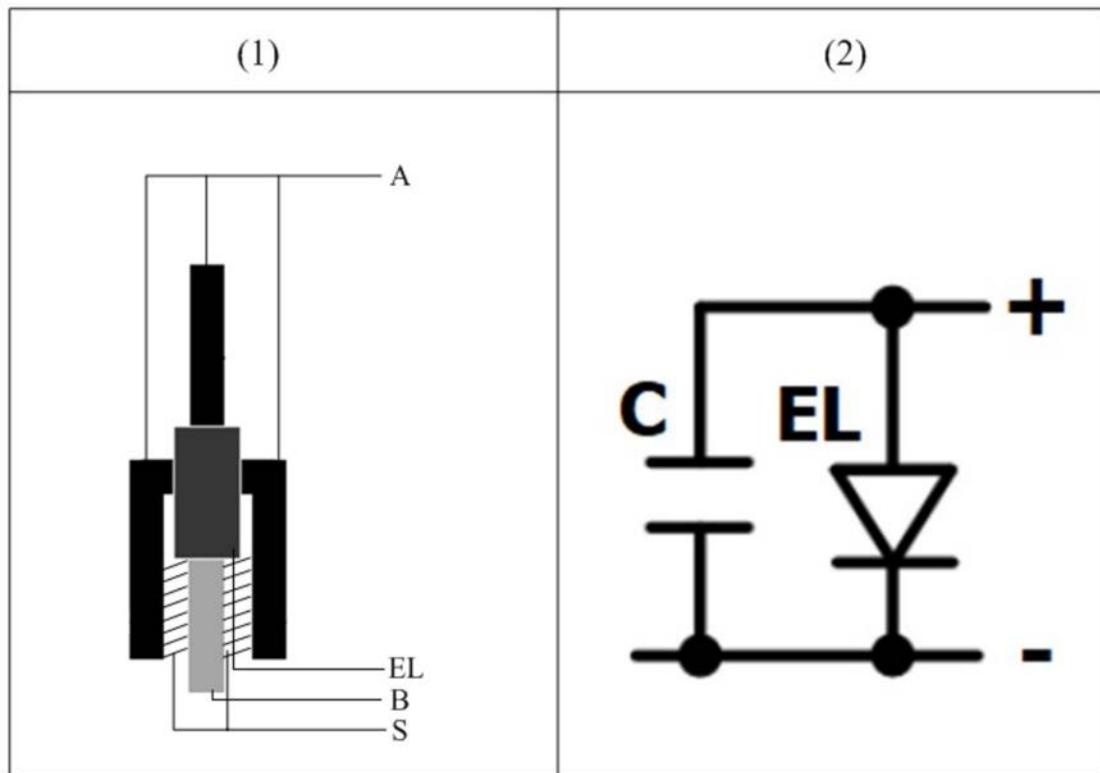


图5

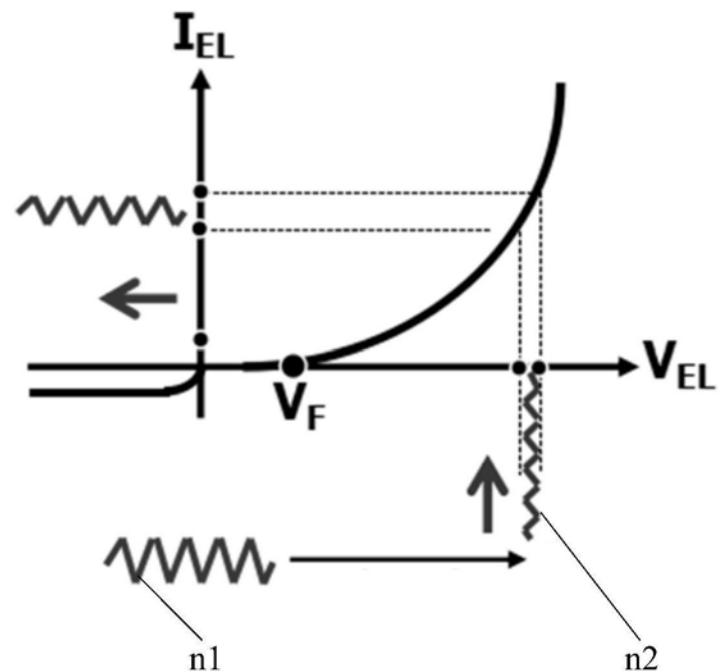


图6

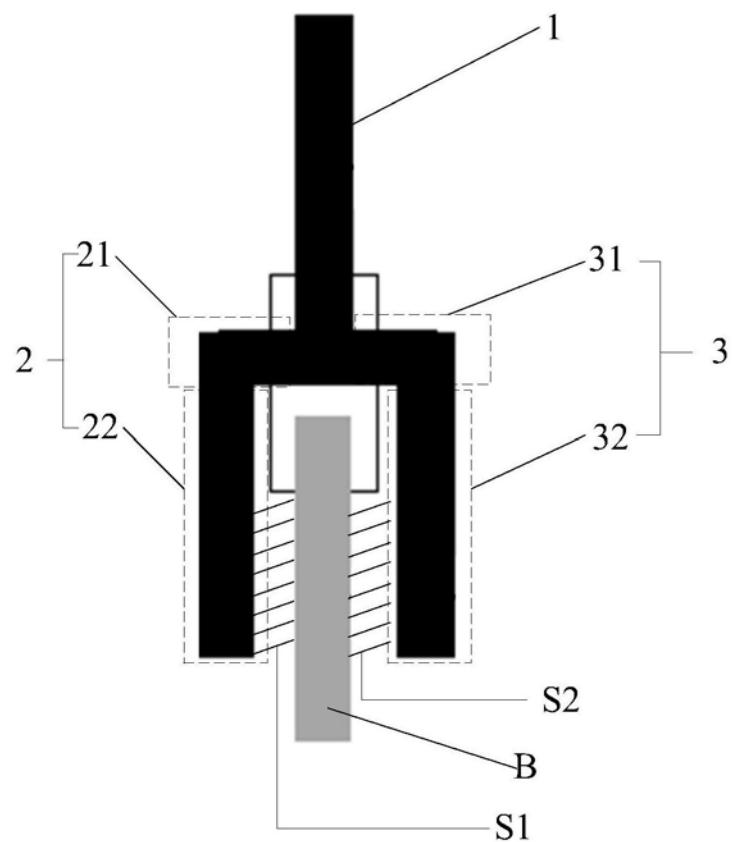


图7

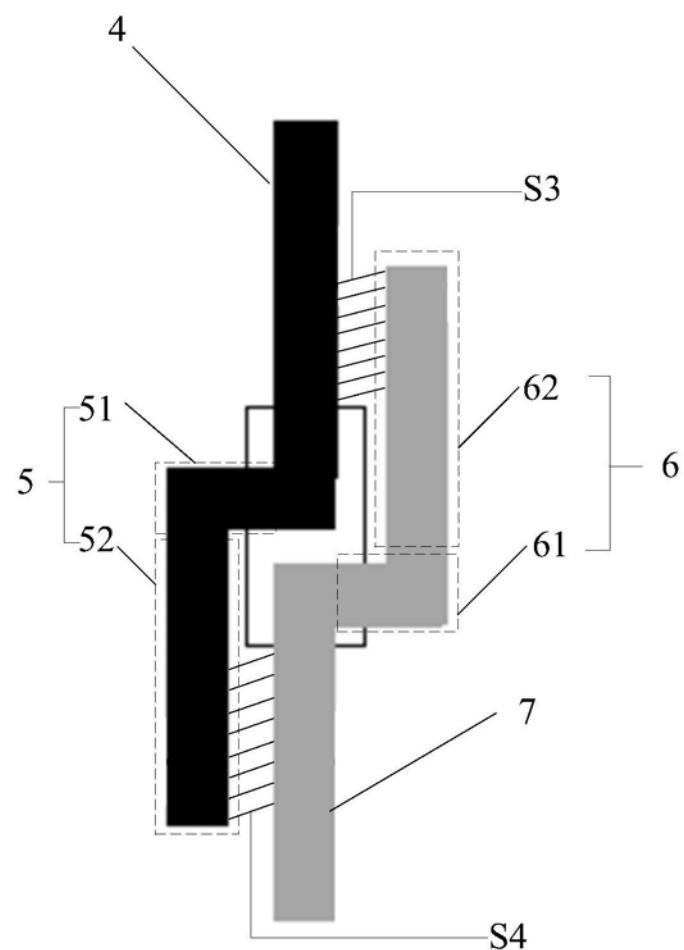


图8

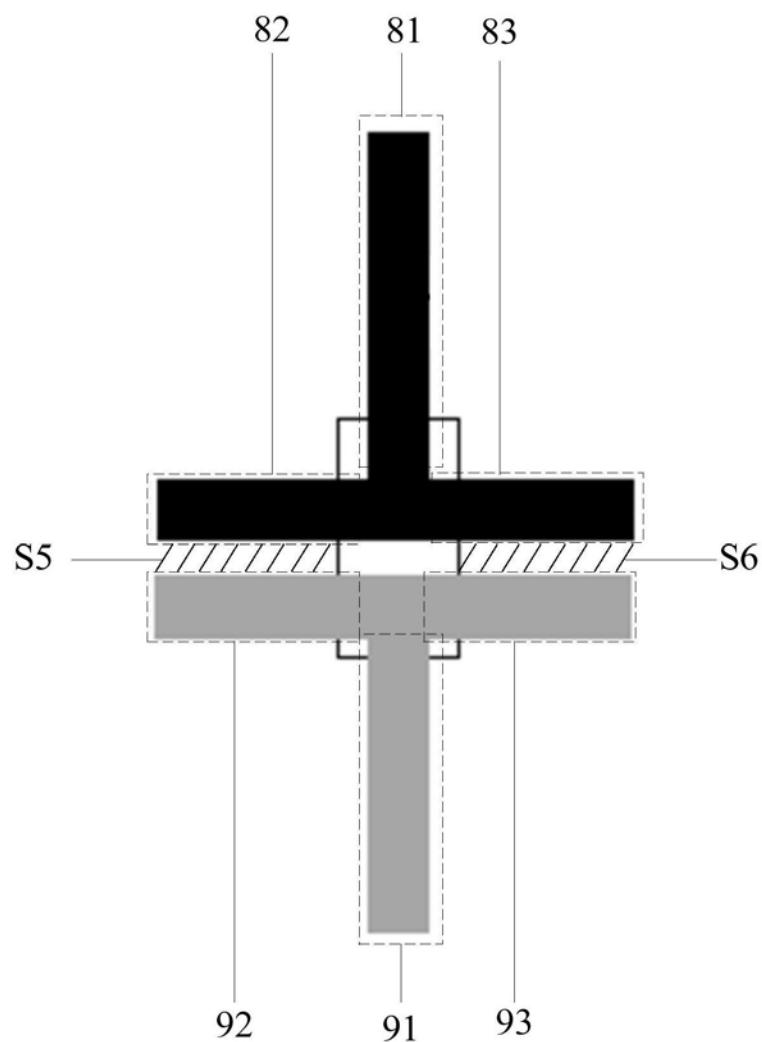


图9

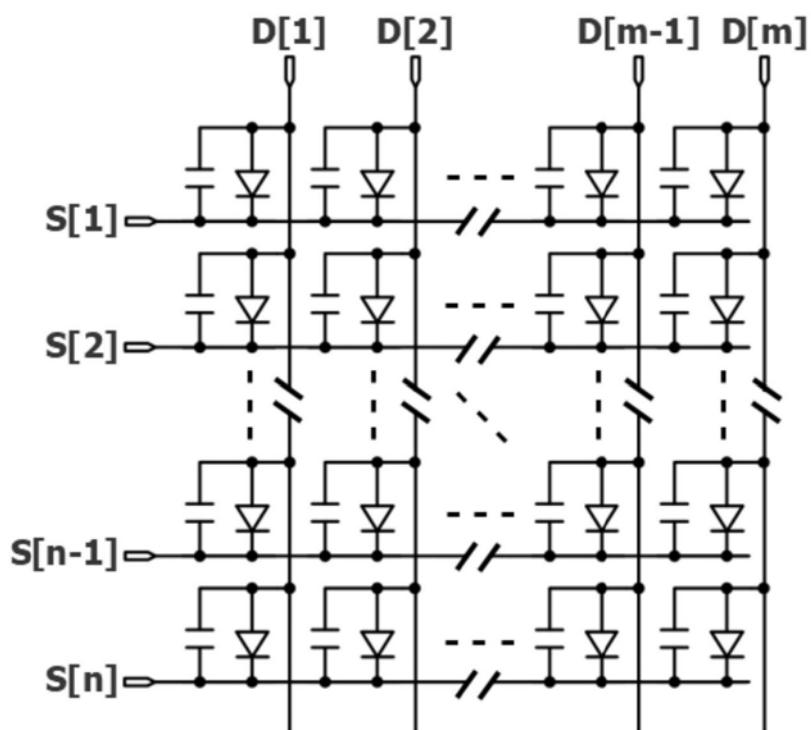


图10

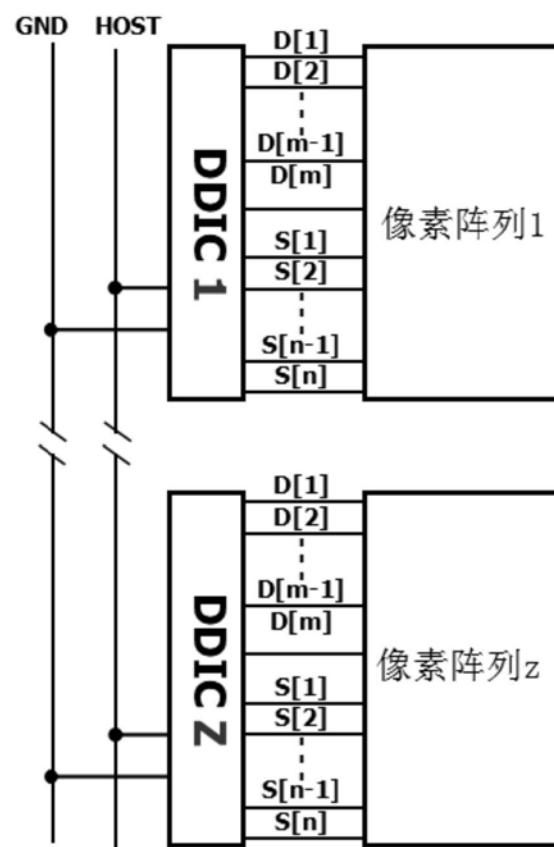


图11

专利名称(译)	一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置		
公开(公告)号	CN111129003A	公开(公告)日	2020-05-08
申请号	CN201911312110.0	申请日	2019-12-18
[标]发明人	郑士嵩		
发明人	郑士嵩		
IPC分类号	H01L27/02 H01L27/15 H01L27/32 H01L51/52		
代理人(译)	王永文		
外部链接	Espacenet	Sipo	

摘要(译)

本发明提供一种电致发光器件的覆晶结构和显示装置，所述覆晶结构包括：电致发光器件、与所述电致发光器件的阳极连接的阳极覆晶连线和与所述电致发光器件的阴极连接的阴极覆晶连线，其中，所述阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间设有绝缘层。本发明中，阳极覆晶连线和阴极覆晶连线之间形成电容，通过此电容，可以减缓电信号应用到电致发光器件的反应速度，当存在扰动信号时，扰动信号的电压信号变化小，在反应速度降低的条件下，可合理降低非理想扰动的影响，增强显示的稳定性。

